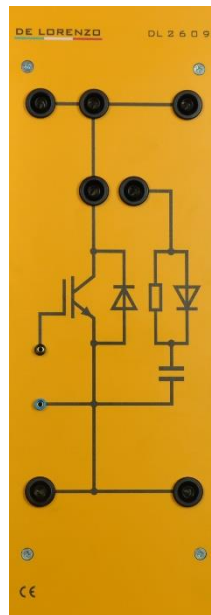


## DL 2609



### IGBT

Transistor bipolare a gate isolato (IGBT) a canale N con diodo inverso ultraveloce di protezione usato come interruttore veloce nei regolatori a commutazione e negli inverter.

#### Caratteristiche tecniche:

Tensione collettore-emettitore:  $U_{CES} = 600\text{ V}$   
 Corrente continua di collettore:  $I_c = 24\text{ A}$  at  $T_c = 25^\circ\text{C}$   
 Tensione di saturazione collettore-emettitore:  
 $U_{CESat} = 1.8\text{ V}_{typ}$  at  $I_c = 15\text{ A}$   
 Tensione gate-emettitore:  $U_{GE} = \pm 20\text{ V}$

### IGBT

N-channel Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) with anti parallel hyper fast protection diode used as very fast switch in switching regulators and inverters.

#### Technical features:

Collector-emitter voltage:  $U_{CES} = 600\text{ V}$   
 Continuous collector current:  $I_c = 24\text{ A}$  at  $T_c = 25^\circ\text{C}$   
 Collector-emitter saturation voltage:  
 $U_{CESat} = 1.8\text{ V}_{typ}$  at  $I_c = 15\text{ A}$   
 Gate-emitter voltage:  $U_{GE} = \pm 20\text{ V}$

### IGBT

Transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT) canal-N con diodo ultraveloz de protección en inversa usado como interruptor veloz en reguladores e inversores.

#### Características técnicas:

Voltaje colector-emisor:  $U_{CES} = 600\text{ V}$   
 Corriente continua de colector:  $I_c = 24\text{ A}$  at  $T_c = 25^\circ\text{C}$   
 Voltaje colector-emisor de saturación:  
 $U_{CESat} = 1.8\text{ V}_{typ}$  at  $I_c = 15\text{ A}$   
 Voltaje compuerta-emisor:  $U_{GE} = \pm 20\text{ V}$

### IGBT

Transistor bipolaire avec grille isolé (IGBT) à canal N avec diode antiparallèle ultrarapide de protection utilisé comme interrupteur rapide dans les régulateurs à commutation et dans les inverseurs.

#### Caractéristiques techniques:

Tension collecteur-émetteur:  $U_{CES} = 600\text{ V}$   
 Courant continu de collecteur  $I_c = 24\text{ A}$  à  $T_c = 25^\circ\text{C}$   
 Tension de saturation collecteur-émetteur :  
 $U_{CESat} = 1.8\text{ V}_{typ}$  à  $I_c = 15\text{ A}$   
 Tension grille-émetteur:  $U_{GE} = \pm 20\text{ V}$